

PCT

世界知的所有権機関  
国際事務局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

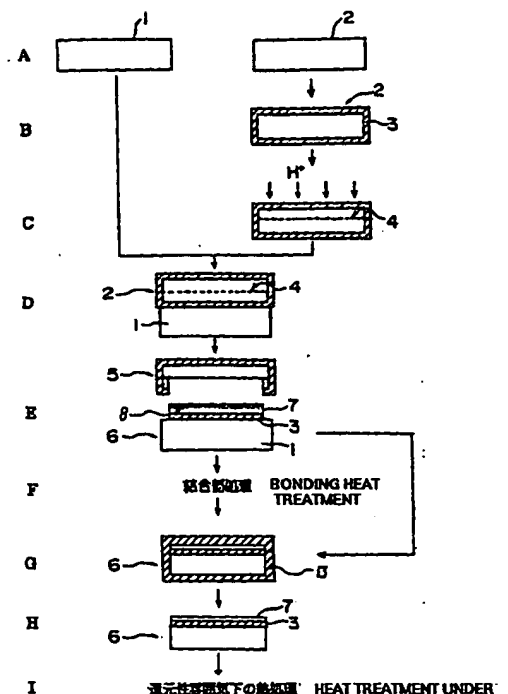
|  |   |  |
|--|---|--|
| (51) 国際特許分類7<br>H01L 27/12   | A1  | (11) 国際公開番号<br><b>WO00/24059</b><br><br>(43) 国際公開日<br>2000年4月27日(27.04.00) |
| (21) 国際出願番号<br>PCT/JP99/05588<br>(22) 国際出願日<br>1999年10月8日(08.10.99)<br>(30) 優先権データ<br>特願平10/314018 1998年10月16日(16.10.98) JP<br>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)<br>信越半導体株式会社<br>(SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.)[JP/JP]<br>〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目4番2号 Tokyo, (JP)<br>エス オー アイ テック エス エー(SOITEC S.A.)[FR/FR]<br>F-38190 ベルニン フォンティーン パルク テクノロジーク<br>Bernin, (FR)<br>(72) 発明者 ; および<br>(75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ)<br>阿賀浩司(AGA, Hiroji)[JP/JP]<br>橋 直人(TATE, Naoto)[JP/JP]<br>三谷 清(MITANI, Kiyoshi)[JP/JP]<br>〒379-0196 群馬県安中市磯部2丁目13番1号<br>信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内 Gumma, (JP) | (74) 代理人<br>好宮幹夫(YOSHIMIYA, Mikio)<br>〒111-0041 東京都台東区元浅草2丁目6番4号<br>上野三生ビル4F Tokyo, (JP)<br><br>(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)<br><br>添付公開書類<br>国際調査報告書 |  |

(54)Title: **METHOD OF PRODUCING SOI WAFER BY HYDROGEN ION IMPLANTING SEPARATION METHOD AND SOI WAFER PRODUCED BY THE METHOD**

(54)発明の名称 水素イオン注入剥離法によってSOIウエーハを製造する方法およびこの方法で製造されたSOIウエーハ

(57) Abstract

A method of producing a high-quality SOI wafer by using a hydrogen ion implanting separation method, wherein a damaged layer remaining on the SOI layer surface after separation and a surface roughness are removed with an SOI layer film thickness kept uniform. A method of producing an SOI wafer by using a hydrogen ion implanting separation method, wherein an oxide film is formed, after a bonding heat treatment, on an SOI layer by a heat treatment under an oxidizing atmosphere, the oxide film is then removed and a heat treatment under a reducing atmosphere is applied; a method of producing an SOI wafer by using a hydrogen ion implanting separation method, wherein an oxide film is formed, after a separation heat treatment, on an SOI layer by a heat treatment under an oxidizing atmosphere, the oxide film is then removed and a heat treatment under a reducing atmosphere is applied; and an SOI wafer produced by the above methods.



(57)要約

水素イオン注入剥離法において、剥離後にSOI層表面に残留するダメージ層、表面粗さを、SOI層の膜厚均一性を維持しつつ除去することにより、高品質のSOIウエーハを製造する方法を提供する。本発明によれば、水素イオン注入剥離法によってSOIウエーハを製造する方法において、結合熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成した後に該酸化膜を除去し、次に還元性雰囲気下の熱処理を加えるSOIウエーハを製造する方法。および、水素イオン注入剥離法によってSOIウエーハを製造する方法において、剥離熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成した後に該酸化膜を除去し、次に還元性雰囲気下の熱処理を加えるSOIウエーハを製造する方法、およびこれらの方法で製造されたSOIウエーハが提供される。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦  
AL アルバニア  
AM アルメニア  
AT オーストリア  
AU オーストラリア  
AZ アゼルバイジャン  
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ  
BB バルバドス  
BF ベルギー  
BG ブルガリア  
BJ ベナン  
BR ブラジル  
BY ベラルーシ  
CA カナダ  
CF 中央アフリカ  
CG コンゴ  
CH スイス  
CI コートジボアール  
CM カメルーン

DM ドミニカ  
EE エストニア  
ES スペイン  
FI フィンランド  
FR フランス  
GA ガボン  
GB 英国  
GD グレナダ  
GE グルジア  
GH ガーナ  
GM ガンビア  
GN キニア  
GW キニア・ビサウ  
GR ギリシャ  
HR クロアチア  
HU ハンガリー  
ID インドネシア  
IE アイルランド  
IL イスラエル  
IN インド  
IS アイスランド

KZ カザフスタン  
LC セントルシア  
LI リヒテンシュタイン  
LK スリ・ランカ  
LR リベリア  
LS レソト  
LT リトアニア  
LU ルクセンブルグ  
LV ラトヴィア  
MA モロッコ  
MC モナコ  
MD モルドヴァ  
MG マダガスカル  
MK マケドニア  
ML マリ  
MN モンゴル  
MR モーリタニア  
MW マラウイ  
MX メキシコ  
NE ニジェール

RU ロシア  
SD スーダン  
SE スウェーデン  
SG シンガポール  
SI スロヴェニア  
SK スロヴァキア  
SL シエラ・レオネ  
SN セネガル  
SZ スワジランド  
TD チャード  
TG トーゴ  
TJ タジキスタン  
TZ タンザニア  
TM トルクメニスタン  
TR トルコ  
TT トリニダード・トバゴ  
UA ウクライナ  
UG ウガンダ  
US 米国  
UZ ウズベキスタン  
VN ヴィエトナム

## 明 細 書

水素イオン注入剥離法によってＳＯＩウエーハを製造する方法  
およびこの方法で製造されたＳＯＩウエーハ

5

## 技術分野

本発明は、イオン注入したウエーハを結合後に剥離してＳＯＩ（Silicon On Insulator）ウエーハを製造する、いわゆる水素イオン注入剥離法（スマートカット法とも呼ばれている）において、剥離後にＳＯＩ層上に残留するダメージ層、  
10 表面粗さを除去するとともに、工程の簡略化を図る方法に関する。

## 背景技術

最近、ＳＯＩウエーハの製造方法として、イオン注入したウエーハを結合後に剥離してＳＯＩウエーハを製造する方法（水素イオン注入剥離法：スマートカット法と呼ばれる技術）が新たに注目され始めている。この方法は、二枚のシリコンウエーハの内、少なくとも一方に酸化膜を形成すると共に、一方のシリコンウエーハの上面から水素イオンまたは希ガスイオンを注入し、該ウエーハ内部に微小気泡層（封入層）を形成させた後、該イオンを注入した方の面を酸化膜を介して他方のシリコンウエーハと密着させ、その後熱処理（剥離熱処理）を加えて微小気泡層を劈開面として一方のウエーハを薄膜状に剥離し、さらに熱処理（結合熱処理）を加えて強固に結合してＳＯＩウエーハとする技術（特開平５－２１１  
15 １２８号参照）である。この方法では、劈開面（剥離面）は良好な鏡面であり、ＳＯＩ層の膜厚の均一性も高いＳＯＩウエーハが比較的容易に得られている。

しかし、水素イオン注入剥離法によりＳＯＩウエーハを作製する場合において  
25 は、剥離後のＳＯＩウエーハ表面にイオン注入によるダメージ層が存在し、また表面粗さが通常のシリコンウエーハの鏡面に比べて大きなものとなる。したがって、水素イオン注入剥離法では、このようなダメージ層、表面粗さを除去することが必要になる。従来、このダメージ層等を除去するために、結合熱処理後の最

しかし、S O I 層に機械加工である研磨をしてしまうと、研磨の取り代が均一でないために、水素イオン注入、剥離によって達成された S O I 層の膜厚均一性が悪化してしまうという問題が生じる。また、結合熱処理後に鏡面研磨をするのでは、工程が多く煩雑であり、コスト的にも不利である。

しかし、この犠牲酸化のみでは、SOI層表面の表面粗さを十分に改善することができないために、結局、面粗さの改善のために機械研磨であるタッチポリッシュが必要となり、SOI層の膜厚均一性を劣化させてしまう。また、酸化性雰囲気下の熱処理を行うと、SOI層表面のダメージに起因してOSF（酸化誘起積層欠陥）が発生することがある。

しかし、水素イオン注入剥離法で得られたSOIウエーハのSOI層中のダメージは、表面側が大きく、内部になるに従い小さくなる。従って、上記のような還元性の熱処理を加えると、ダメージの回復はSOI層の内部から表面側に進行することになるが、表面側のダメージが大きい場合には、高温、長時間の熱処理が必要とされ、高温、長時間の熱処理を行っても、場合によっては完全に回復できないこともあった。

ダメージの大きさや深さは、水素イオン注入の注入エネルギーの大きさやドーズ量に起因するものであるので、例えば、厚いSOI層や厚い埋め込み酸化膜を有するSOIウエーハを製造する場合に注入エネルギーを大きくする必要がある

あるような場合には、上記の問題は顕著になる。

さらに、水素等の還元性雰囲気下で高温、長時間の熱処理を行うと、SOI層表面のシリコンがエッチングされて膜厚均一性が劣化すると共に、埋め込み酸化膜にエッチピットが生じることがあった。これは、SOI層にCOP (Crystal

5 Originated Particle) のような欠陥があり、それが下地の酸化膜までつながっていると、COPは消滅せずにそのまま残るか、あるいは拡大することもあるため、欠陥を通して侵入した水素等によって埋め込み酸化膜までもがエッチングされてしまい、ここにピットが形成されることが原因である。このエッチピットは、その近傍のSOI層にも影響を与えるため問題であった。

10 以上のように、水素イオン注入剥離法によって得られるSOIウエーハのダメージ層や表面粗さをSOI層の膜厚均一性を維持しつつ除去するために、種々の方法が提案されたが、いまだに満足できるものはなく、適切な解決方法が望まれていた。

#### 15 発明の開示

そこで、本発明はこのような問題点に鑑みなされたもので、水素イオン注入剥離法において、剥離後にSOI層表面に残留するダメージ層、表面粗さを、SOI層の膜厚均一性を維持しつつ除去することにより、高品質のSOIウエーハを製造する方法を提供すると共に、ウエーハ製造の生産性を向上させることを目的とする。

20

上記課題を解決するための本発明は、水素イオン注入剥離法によってSOIウエーハを製造する方法において、結合熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成した後に該酸化膜を除去し、次に還元性雰囲気下の熱処理を加えることを特徴とするSOIウエーハを製造する方法である。

25 このように、結合熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成してから酸化膜を除去する犠牲酸化を行うことにより、酸化膜中にSOI層表面のダメージ層の一部または全部を取り込むことができるので、これを除去すればダメージ層を効率良く除去することができる。そして、次に還元性雰囲気

ともに、表面粗さを改善することができ、すでにSOI層表面のダメージ層の一部または全部を除去しているので熱処理時間も短時間とすることができる。そのため、SOI層や埋め込み酸化膜がエッチングされることも防止できる。さらに、この方法では、機械加工である研磨等を行う必要がないため、SOI層の膜厚均一性が劣化することもなく、水素イオン注入剥離法により極めて高品質のSOI

5 ウェーハを、より高生産性で製造することができる。

また、本発明は、水素イオン注入剥離法によってSOIウェーハを製造する方法において、剥離熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成した後に該酸化膜を除去し、次に還元性雰囲気下の熱処理を加えることを特徴とするSOIウェーハを製造する方法である。

10

このように、剥離熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成してから酸化膜を除去することにより、酸化膜中にSOI層表面のダメージ層の一部または全部を取り込むことができるので、これを除去することによりダメージ層を効率良く除去することができる。そして、還元性雰囲気下の熱処理を加えることにより、SOI層に残留するダメージ層を回復させるとともに、表面粗さを改善することができ、すでにSOI層表面のダメージ層の一部または全部を除去しているので短時間で効果的に熱処理を行うことができる。そのため、SOI層や埋め込み酸化膜がエッチングされることも防止できる。さらに、この方法では、機械加工である研磨等を行う必要がないため、SOI層の膜厚均一性が劣化することもない。

15

20

この場合、酸化膜を形成してから結合熱処理を行えば、酸化膜が結合熱処理中の表面保護膜の役割を果たすことになり、結合熱処理を非酸化性雰囲気で行う場合に生ずるSOI層表面のエッチングを防ぐことができる。あるいは、この酸化性雰囲気下での熱処理もしくは還元性熱処理を、結合熱処理をも兼ねるものとすることもできる。このようにすれば、結合熱処理を別個独立して行う必要はなくなり、水素イオン注入剥離法により極めて高品質のSOIウェーハを、より簡略な工程とし高生産性で製造することができる。

25

この場合、前記還元性雰囲気下の熱処理は、急速加熱・急速冷却装置を用いて

このように、還元性雰囲気下の熱処理を急速加熱・急速冷却装置を用いて、1000～1300℃の高い温度で、1～60秒間の短時間に行えば、極めて短時間で効率よくSOIウェーハ表面のダメージ層および面粗さを改善することができる。さらに、SOI層や埋め込み酸化膜がエッチングされることを防止することもできる。

また、前記還元性雰囲気は、100%水素雰囲気、あるいは水素とアルゴンの混合雰囲気とすることが好ましい。

このような熱処理雰囲気とすれば、確実にSOI層の表面のダメージ層および面粗さを改善することができる。

10 さらに、前記酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に形成される酸化膜の厚さは、酸化膜形成前におけるSOI層表面のダメージ層の厚さの2倍以上とすることができる。

このように、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に形成される酸化膜の厚さを、酸化膜形成前におけるSOI層表面のダメージ層の厚さの2倍以上とすれば、形成される酸化膜中にダメージ層のほぼ全部を取り込むことができるので、15 後に行う還元性雰囲気下の熱処理時間はさらに短くすることができ、効率良くダメージ層等の除去を行うことができる。

さらに、前記酸化性雰囲気下の熱処理温度は、前記還元性雰囲気下の熱処理温度より低温とすることが好ましい。

20 これは、酸化性雰囲気下の熱処理を行うと、SOI層表面のダメージに起因してOSFが発生することがあるが、酸化性雰囲気下の熱処理温度よりも高温でその後の還元性雰囲気下の熱処理を行えば、SOI層表面に発生したOSFが除去されやすいからである。

そして、前記酸化性雰囲気下の熱処理温度は、1000℃以下とすることが好25 ましい。

このように酸化性雰囲気下の熱処理温度を1000℃以下とすることにより、SOI層にOSFが発生することを防ぐことができる。

そして、本発明の方法により製造されたSOIウェーハは、SOI層のダメー

一ハとなる。

以上説明したように、本発明では、水素イオン注入剥離法において、剥離後に、犠牲酸化と還元性雰囲気下の熱処理を組み合わせる行うことにより、SOI層に残留するダメージ層、表面粗さを、SOI層の膜厚均一性を維持しつつ、効率良  
5 く除去することができる。したがって、きわめて高品質のSOIウエーハを高生産性で製造することができる。

#### 図面の簡単な説明

図1A～図1Jは、本発明の水素イオン注入剥離法によるSOIウエーハの製造工程の一例を示すフロー図である。  
10

図2は、剥離後のSOIウエーハのダメージ層を測定した結果図である。

図3は、急速加熱・急速冷却装置の一例を示した、概略図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明についてさらに詳述するが、本発明はこれらに限定されるものではない。  
15

本発明は、水素イオン注入剥離法によりSOIウエーハを製造するに際して、結合熱処理後あるいは剥離熱処理後に、犠牲酸化と還元性雰囲気下の熱処理とを組み合わせる行うことにより、SOI層の膜厚均一性を維持しつつ、SOI層の  
20 ダメージ層及び表面粗さを除去することができることを見出し、諸条件を精査して完成されたものである。

すなわち、従来の方法のうち、犠牲酸化のみを行う方法では、SOI層のダメージ層を除去することはできても表面粗さを十分に改善することはできず、結局SOI層の膜厚均一性を劣化させる研磨等を行わなくてはならなかった。

一方、還元性雰囲気下の熱処理のみを行う方法では、SOI層の表面側のダメージ層を回復させるのに長時間を要し、長時間の熱処理を行うことによりSOI層や埋め込み酸化膜がエッチングされる等の弊害があった。  
25

そこで、本発明では、これらの工程を組み合わせる行うことにより、



ち、まず犠牲酸化により、ダメージの大きい表面側のダメージ層を除去してしまう。そして還元性雰囲気下の熱処理により、残りのダメージの小さいバルク側のダメージ層のダメージを回復させ、かつ表面粗さを改善する。このようにすれば、研磨等の機械的な加工は不要であり、SOI層の膜厚均一性を維持しつつ、ダメージ層の除去と表面粗さの改善をすることが可能である。さらに、還元性雰囲気下の熱処理時間を短くすることができるため、SOI層や埋め込み酸化膜がエッチングされることを防止することができる。さらに、犠牲酸化により生じたOSFを後に行う還元性雰囲気下の熱処理で除去することができるという効果も有するものとなる。

- 10      以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

ここで、図1A～図1Jは本発明の水素イオン注入剥離法でSOIウエーハを製造する方法の製造工程の一例を示すフロー図である。

以下、本発明を2枚のシリコンウエーハを結合する場合を中心に説明する。

- 15      まず、図1A～図1Jの水素イオン注入剥離法において、工程Aでは、2枚のシリコン鏡面ウエーハを準備するものであり、デバイスの仕様に合った支持基板となるベースウエーハ1とSOI層となるボンドウエーハ2を準備する。

次に工程Bでは、そのうちの少なくとも一方のウエーハ、ここではボンドウエーハ2を熱酸化し、その表面に約0.1～2.0 $\mu$ m厚の酸化膜3を形成する。

- 20      工程Cでは、表面に酸化膜を形成したボンドウエーハ2の片面に対して水素イオンまたは希ガスイオン、ここでは水素イオンを注入し、イオンの平均進入深さにおいて表面に平行な微小気泡層（封入層）4を形成させる。

- 25      工程Dは、水素イオンを注入したボンドウエーハ2の水素イオン注入面に、ベースウエーハ1を酸化膜を介して重ね合せて密着させる工程であり、常温の清浄な雰囲気下で2枚のウエーハの表面同士を接触させることにより、接着剤等を用いることなくウエーハ同士が接着する。

次に、工程Eは、封入層4を境界として剥離することによって、剥離ウエーハ

分離する剥離熱処理工程で、例えば不活性ガス雰囲気下約500℃以上の温度で熱処理を加えれば、結晶の再配列と気泡の凝集とによって剥離ウエーハ5とSOIウエーハ6に分離される。そして、この剥離したままのSOIウエーハ表面のSOI層7には、ダメージ層8が残留する。

- 5      ここまでの工程は、本発明の方法も、従来の水素イオン注入剥離法と同じである。そして本発明は、この剥離工程後、2つの方法に分かれる。

まず、第1の方法では、剥離工程の後、従来通り工程Fで、結合熱処理工程を行う。この工程は、前記工程D、Eの密着工程および剥離熱処理工程で密着させたウエーハ同士の結合力では、そのままデバイス工程で使用するには弱いので、  
10      結合熱処理としてSOIウエーハ6に高温の熱処理を施し結合強度を十分なものとする。この熱処理は例えば不活性ガス雰囲気下、1000～1300℃で30分から2時間の範囲で行うことが好ましい。

そして、次に従来法ではタッチポリッシュ等の研磨の工程を行い、SOI層7の表面である剥離面に存在するダメージ層および表面粗さを除去する工程を行う  
15      が、本発明では、工程Gにおいて、まず酸化性雰囲気下の熱処理を行い、SOI層7に酸化膜13を形成して、ダメージ層8を酸化膜13に取り込むようにする。

そして、工程Hでは、SOI層7に形成した酸化膜13を除去する。この酸化膜13の除去は、例えばHFを含む水溶液でエッチングすることにより行えばよい。HFを含む水溶液でエッチングするようにすれば、酸化膜13のみがエッチ  
20      ングにより除去され、犠牲酸化によりダメージ層を除去したSOIウエーハ6を得ることができる。しかも、このようなウエーハのHF処理は簡単であるとともに低コストであるという有利性もある。

さらに、工程Iでは、還元性雰囲気下の熱処理を施し、SOI層7の表面の残留ダメージ層8、及び表面粗さを改善する。

25      このように、犠牲酸化熱処理後、還元性雰囲気下の熱処理を加えることによって、SOI層表面に残留するダメージ層8、及び表面粗さを、膜厚均一性を悪化させることなく除去することができ、すでにダメージ層8の一部あるいは全部を

処理は短時間で効率良く終了させることができる。そのためSOI層7や埋め込み酸化膜3がエッチングされることを防止することができる。

一方、本発明の第2の方法では、剥離工程の後、単独の結合熱処理工程Fを行うことなく、SOI層7の表面を研磨することなく、直接工程Gの酸化性雰囲気下の熱処理を行う。

すなわち、剥離熱処理後、すぐに酸化性雰囲気下の熱処理を加えた後（工程G）、酸化膜13を除去し（工程H）、還元性雰囲気下の熱処理を加えることによって（工程I）、SOI層7の表面に残留するダメージ層8、表面粗さを除去する。この場合、酸化性雰囲気下の熱処理（工程G）と酸化膜13の除去（工程H）の間に、結合熱処理（工程F）を行うことができる。このようにすると、機械的な研磨をする必要がなくなり、膜厚均一性を悪化させることがなくなることに加えて、酸化膜13が結合熱処理中の表面保護膜の役割を果たすため、結合熱処理が非酸化性雰囲気の場合、SOI層7の表面がエッチングされ、面あれが生ずるのを防ぐ効果がある。

一方、結合熱処理（工程F）を省略してしまい、還元性雰囲気下の熱処理（工程I）を結合熱処理（工程F）をも兼ねるものとすることもできる。このようにすると、結合熱処理を単独で行う必要がなくなるので、より簡略な工程とすることができ、高品質なSOIウエーハの生産性の向上にも寄与することができる。

以上の工程を経て結晶品質が高く、膜厚均一性の高いSOI層7を有する高品質のSOIウエーハ6を製造することができる（工程J）。

そして、上記のような工程Gの酸化性雰囲気下の熱処理で形成される酸化膜13の厚さは、酸化膜13形成前におけるSOI層7表面のダメージ層8の厚さの2倍以上とすることが好ましい。これは、シリコンの熱酸化は浸透型であり、シリコン表面に熱酸化膜を形成すると、シリコンの表層部のうち、形成される酸化膜の厚さの約半分の深さの層が酸化膜に取り込まれるからである。したがって、ダメージ層8の厚さの2倍以上の膜厚の酸化膜13を形成するようにすれば、酸化膜13にダメージ層8の全部分を取り込むことができるので、後に行う還元性

しかし、本発明はこれに限定されず、S O I 層 7 の厚さや埋め込み酸化膜 3 の厚さ等の条件により、形成する酸化膜 1 3 の膜厚を任意に変更し、犠牲酸化によるダメージ層 8 の除去と、還元性熱処理によるダメージ層 8 の回復との割合を変化させることも可能である。

- 5      また、この工程 G における酸化熱処理の熱処理温度は、後に行う還元性熱処理の熱処理温度よりも低温とすることが好ましく、より好ましくは 1 0 0 0 °C 以下とする。

これは、前述したように、酸化性雰囲気下の熱処理を行うことにより発生する O S F は、後の還元性熱処理により除去することができるが、酸化性熱処理の熱  
10      処理温度よりも高温でその後の還元性熱処理を行うことにより、O S F が除去され易くなるからである。さらに酸化熱処理を 1 0 0 0 °C 以下の温度で行うことにより、O S F の発生自体を抑制することができるため、この低い温度範囲で熱処理を行うことがより好ましいのである。

- また、上記のような工程 I の還元性雰囲気下の熱処理を効率良く行うためには、  
15      急速加熱・急速冷却装置を用いて 1 0 0 0 ~ 1 3 0 0 °C の温度範囲で、1 ~ 6 0 秒間行うことが好ましい。

このように、犠牲酸化熱処理後の S O I ウェーハに急速加熱・急速冷却装置を用いて還元性雰囲気下の熱処理を施せば、極めて短時間で効率よく S O I ウェーハ表面のダメージ層 8 および表面粗さを改善することができる。さらに、短時間  
20      で効率よく還元性熱処理を行うことができるので、S O I 層 7 や埋め込み酸化膜 3 のエッチングを防止する効果はより高いものとなる。

このような、S O I ウェーハを還元性雰囲気下で急速加熱・急速冷却することができる装置としては、熱放射によるランプ加熱器のような装置を挙げることができる。また、市販されているものとして、例えば A S T 社製、S H S - 2 8 0  
25      0 のような装置を挙げることができ、これらは特別複雑で高価なものではない。

ここで、本発明で用いたシリコン単結晶ウェーハの急速加熱・急速冷却装置 ( R T A 装置 ) の一例を示す。図 3 は、R T A 装置の概略図である。

このベルジャ 21 内でウエーハを熱処理するようになっている。加熱は、ベルジャ 21 を囲繞するように配置される加熱ヒータ 22, 22' によって行う。この加熱ヒータは上下方向で分割されており、それぞれ独立に供給される電力を制御できるようになっている。もちろん加熱方式は、これに限定されるものではなく、  
5 いわゆる輻射加熱、高周波加熱方式としてもよい。加熱ヒータ 22, 22' の外側には、熱を遮蔽するためのハウジング 23 が配置されている。

炉の下方には、水冷チャンバ 24 とベースプレート 25 が配置され、ベルジャ 21 内と、外気とを封鎖している。そしてウエーハ 28 はステージ 27 上に保持されるようになっており、ステージ 27 はモータ 29 によって上下動自在な支持  
10 軸 26 の上端に取りつけられている。水冷チャンバ 24 には横方向からウエーハを炉内に出し入れできるように、ゲートバルブによって開閉可能に構成される不図示のウエーハ挿入口が設けられている。また、ベースプレート 25 には、ガス流入口と排気口が設けられており、炉内ガス雰囲気調整できるようになっている。

15 以上のような熱処理装置 20 によって、ウエーハの急速加熱・急速冷却する熱処理は次のように行われる。

まず、加熱ヒータ 22, 22' によってベルジャ 21 内を、例えば 1000 ~ 1300℃の所望温度に加熱し、その温度に保持する。分割された加熱ヒータそれぞれを独立して供給電力を制御すれば、ベルジャ 21 内を高さ方向に沿って温  
20 度分布をつけることができる。したがって、ウエーハの処理温度は、ステージ 27 の位置、すなわち支持軸 26 の炉内への挿入量によって決定することができる。

ベルジャ 21 内が所望温度で維持されたなら、熱処理装置 20 に隣接して配置される、不図示のウエーハハンドリング装置によってウエーハを水冷チャンバ 24 の挿入口から入れ、最下端位置で待機させたステージ 27 上に例えば SiC ボ  
25 ートを介してウエーハを乗せる。この時、水冷チャンバ 24 およびベースプレート 25 は水冷されているので、ウエーハはこの位置では高温化しない。

そして、ウエーハのステージ 27 上への載置が完了したなら、すぐにモータ 2

0℃以上の所望温度位置まで上昇させ、ステージ上のウエーハに高温熱処理を加える。この場合、水冷チャンバ24内のステージ下端位置から、所望温度位置までの移動には、例えば20秒程度しかかからないので、ウエーハは急速に加熱されることになる。

- 5       そして、ステージ27を所望温度位置で、所定時間停止（1秒間以上）させることによって、ウエーハに停止時間分の高温熱処理を加えることができる。所定時間が経過し高温熱処理が終了したなら、すぐにモータ29によって支持軸26を炉内から引き抜くことによって、ステージ27を下降させ水冷チャンバ24内の下端位置とする。この下降動作も、例えば20秒程度で行うことができる。ス  
10       テージ27上のウエーハは、水冷チャンバ24およびベースプレート25が水冷されているので、急速に冷却される。最後に、ウエーハハンドリング装置によって、ウエーハを取り出すことによって、熱処理を完了する。

さらに熱処理するウエーハがある場合には、熱処理装置20の温度を降温させてないので、次々にウエーハを投入し連続的に熱処理をすることができる。

- 15       また、上記工程Iにおける還元性雰囲気下の熱処理の雰囲気としては、100%水素雰囲気、あるいは水素とアルゴンの混合雰囲気とすることが好ましい。

このような熱処理雰囲気とすれば、SOIウエーハ表面に害となるような被膜を形成することもなく、確実にSOIウエーハの表面のダメージ層、表面粗さを改善することができるからである。

- 20       以下、本発明の実施例および比較例を挙げて具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

#### （実施例）

- チョクラルスキー法により作製された結晶方位〈100〉で、導電型がp型で、抵抗率が $20\ \Omega \cdot \text{cm}$ のシリコン単結晶インゴットから、直径150mmのシリ  
25       コン鏡面ウエーハを作製した。これらをボンドウエーハとベースウエーハに分け、図1A～図1Jに示す工程に従った本発明の水素イオン注入剥離法によりSOIウエーハを製造することにした。

      まず、図1A～図1Eにしたがい、ボンドウエーハ2を剥離して、SOIウエー

一ハ6を得た。この時、SOI層7の厚さを400nm、埋め込み酸化膜3の厚さは700nmとし、その他イオンの注入等の主な条件は次の通りとした。

1) 水素注入条件: H<sup>+</sup>イオン、注入エネルギー 125keV

注入線量  $8 \times 10^{16} / \text{cm}^2$

5 2) 剥離熱処理条件: N<sub>2</sub>ガス雰囲気下、500℃、30分

こうして厚さ400nmのSOI層7を有するSOIウエーハ6を得ることができたが、図1Eの剥離したままのSOIウエーハ6の表面(剥離面)の表面粗さを、原子間力顕微鏡法により1μm角で測定したところ、それぞれRMS値(二乗平均平方根粗さ)で、平均7.5nmであった。

10 この値は、通常の鏡面研磨されたシリコンウエーハの表面粗さの10倍以上の値で、剥離したままのSOI層の表面は局所的な面粗れが大きいことがわかる。

また、図1Eの、剥離したままのSOIウエーハ6の剥離面のダメージ層8の深さを調べるため、KOH水溶液によるエッチングを行い、表面からのエッチング除去量を変えたSOIウエーハを準備した。そして、これらのSOIウエーハを、H. Gassel (J. Electrochem. Soc., 140, pp 1713, 1993)らにより開示された四段セコエッチング法を行った後顕微鏡観察して、その表面に存在するビット密度をカウントすることによって測定した。エッチング除去量は、0、50、100、150、200、250、300nmとした。測定結果を、図2の曲線Aに示した。

20 この図から、剥離直後のSOIウエーハ6の表面には深さ約150nmのダメージ層があることがわかる。なお、150nmより深い所で観察されるビットは、もともとボンドウエーハに存在する結晶欠陥の密度であると思われる。

また、図1Eの、剥離したままのSOIウエーハ6のSOI層7の膜厚を測定し、膜厚均一性を求めた。膜厚測定は、反射分光法で行い、SOIウエーハ6の面内を外周から10mmを除いて、1mmピッチで数千点測定した。測定値のσ(標準偏差)は、0.9nmであり、従って膜厚均一性(±3σ)は±2.7nmで、悪くとも±3nm以内であることがわかった。従って、剥離後のSOI層7の膜厚均一性は極めて良好であることがわかった。

ねるものとして省略し、図 1 G で、結合熱処理後の S O I ウェーハ 6 を、研磨することなく、水蒸気を含む酸素雰囲気中、900℃の温度で150分間熱処理を加え、S O I 層 7 の表面に約 340 nm の熱酸化膜を形成した。この酸化膜の厚さはダメージ層 8 の厚さの 2 倍以上であるため、ダメージ層 8 は完全に酸化膜中  
5   に取り込まれることとなった。

次に、図 1 H で、この表面に熱酸化膜を有する S O I ウェーハ 6 を、H F 濃度 10% のフッ酸水溶液に浸漬することによって、表面の熱酸化を完全に除去した。

この場合、エッチング終了後のウェーハを直ちに水洗して乾燥することによって、エッチングに伴う新たな面粗れ等が発生しないようにした。

10   さらに図 1 I で、犠牲酸化熱処理後の S O I ウェーハ 6 を、研磨することなく、図 3 に示した急速加熱・急速冷却装置を用いて、水素を含む還元性雰囲気下の熱処理を施した。熱処理条件は、水素 100% 雰囲気下、1225℃で45秒間とした。

なお、熱処理前には、S O I ウェーハ 6 を汚染しないように、熱処理前洗浄をした。この洗浄は、いわゆる R C A 洗浄として広く知られている、(アンモニア/  
15   過酸化水素水)、(塩酸/過酸化水素水) の 2 段洗浄を行った。

そして、還元性雰囲気下の熱処理後の S O I 層 7 の表面粗さを、原子間力顕微鏡法により 1 μm 角で再び測定したところ、それぞれ R M S 値で、平均 0.28 nm であり、面粗さは著しく改善されていた。

20   この値は、通常の鏡面研磨されたシリコンウェーハの表面粗さと同等であり、還元性雰囲気下の熱処理によって著しい表面粗さの改善が図られたことがわかる。

また、この S O I ウェーハ 6 のダメージ層の深さを調べるため、K O H 水溶液によるエッチングを行い、表面からのエッチング除去量を変えた S O I ウェーハを準備した。そして、これらの S O I ウェーハを、前記 H. G a s s e l らにより  
25   開示された四段セコエッチング法を行った後顕微鏡観察して、その表面に存在するピット密度をカウントすることによって測定した。エッチング除去量は、0、50、100、150 nm とした。測定結果を、図 2 の曲線 B に示した。

この図から、犠牲酸化と還元性雰囲気下の熱処理後の S O I ウェーハの表面に



かる。すなわち、SOI層7の表面欠陥密度は、約200個/cm<sup>2</sup>以下であり、深さ方向にこの値は変化せず、確実にダメージ層が除去されていることがわかる。

また、このSOIウエーハのSOI層の膜厚を前記と同様に反射分光法で測定し、再び膜厚均一性を求めた。その結果、測定値の $\sigma$ は、0.9 nmであり、従  
5 って膜厚均一性( $\pm 3\sigma$ )は $\pm 2.7$  nmで、剥離直後と同一の値であった。従って、本発明で製造されるSOIウエーハのSOI層の膜厚均一性は、極めて良好であることがわかった。

#### (比較例)

実施例と同様にして、図1A～図1Eに従い、水素イオン注入剥離法によって、  
10 ボンドウエーハ2を剥離したSOIウエーハ6を得た。この比較例では、実施例と同様に結合熱処理工程Fを省略し、なおかつ工程G、Hの犠牲酸化熱処理工程も行わないこととした。そして、工程Iの還元性雰囲気下の熱処理を、実施例と同一の条件で、急速加熱・急速冷却装置を用いてSOIウエーハ6に施した。

その後、SOI層の表面粗さを実施例と同様に原子間力顕微鏡法により測定し  
15 た。また、このSOIウエーハのダメージ層の状態を前記四段セコエッチング法を行った後顕微鏡観察して、その表面に存在するビット密度をカウントすることによって測定した。エッチング除去量は、0、50、100、150、200、250、300 nmとした。測定結果を図2の曲線Cに示した。さらにSOI層の膜厚を実施例と同様に反射分光法により測定した。

20 この比較例のSOI層の表面粗さは、RMS値で平均0.29 nmであり、表面粗さは改善されていた。また、SOI層の膜厚均一性は $\sigma$ が0.9 nmで、酸化膜厚均一性( $\pm 3\sigma$ )は $\pm 2.7$  nmであり、剥離直後の膜厚均一性が維持されていることがわかった。

しかし、図2の曲線Cに示したように、ダメージが表面から約50 nmの深さ  
25 までに残留しており、ダメージ層が完全に除去されていないことがわかった。このダメージ層は、結局、研磨等で除去せざるを得ず、SOI層の膜厚均一性が劣化することが予想される。

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、

を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

例えば、上記では 2 枚のシリコンウエーハを結合して S O I ウエーハを作製する場合を中心に説明したが、本発明は、この場合に限定されるものではなく、シリコンウエーハにイオン注入後に絶縁性ウエーハと結合し、シリコンウエーハを剥離して S O I ウエーハを製造する場合にも当然に適用可能である。

また、本発明の S O I ウエーハの製造工程も、図 1 に示したものに限定されるものではなく、この工程には、洗浄、熱処理等の他の工程が付加されることもあるし、あるいは一部工程順の入れ替え、省略等が目的に応じて適宜行うことができるものである。

## 請 求 の 範 囲

1. 水素イオン注入剥離法によってSOIウェーハを製造する方法において、結合熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成した後に該酸化膜を除去し、次に還元性雰囲気下の熱処理を加えることを特徴とするSOI  
5 ウェーハを製造する方法。
2. 水素イオン注入剥離法によってSOIウェーハを製造する方法において、剥離熱処理後、酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に酸化膜を形成した後に該酸化膜を除去し、次に還元性雰囲気下の熱処理を加えることを特徴とするSOI  
10 ウェーハを製造する方法。
3. 前記還元性雰囲気下の熱処理は、急速加熱・急速冷却装置を用いて1000～1300℃の温度範囲で、1～60秒間行うことを特徴とする請求項1または請求項2に記載のSOIウェーハを製造する方法。
4. 前記還元性雰囲気を、100%水素雰囲気、あるいは水素とアルゴンの混合  
15 雰囲気とすることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のSOIウェーハを製造する方法。
5. 前記酸化性雰囲気下の熱処理によりSOI層に形成される酸化膜の厚さは、酸化膜形成前におけるSOI層表面のダメージ層の厚さの2倍以上とすることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載のSOIウェーハを製  
20 造する方法。
6. 前記酸化性雰囲気下の熱処理温度は、前記還元性雰囲気下の熱処理温度より低温とすることを特徴とする請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載のSOIウェーハを製造する方法。
7. 前記酸化性雰囲気下の熱処理温度は、1000℃以下とすることを特徴とする  
25 請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載のSOIウェーハを製造する方法。
8. 請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載の方法により製造されたSOIウェーハ。

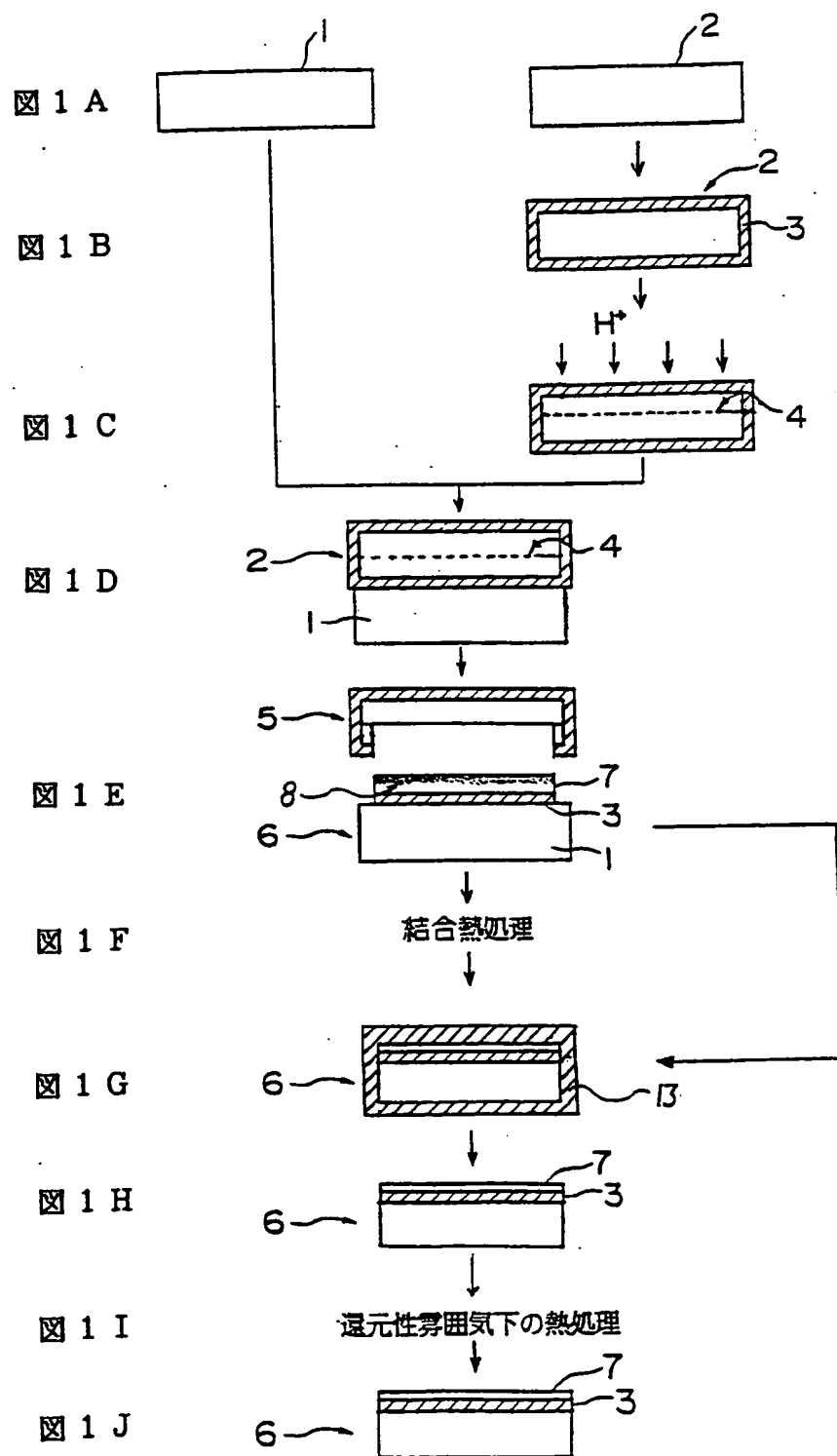


図 2

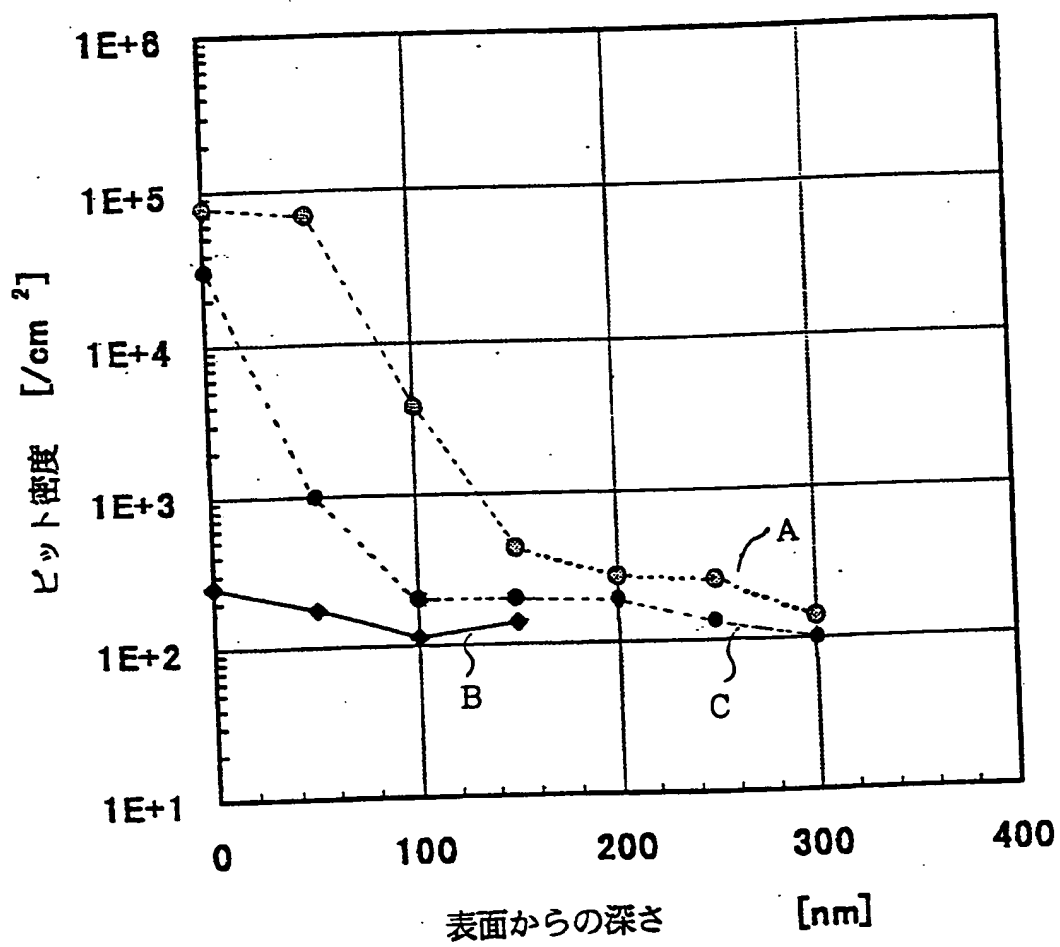
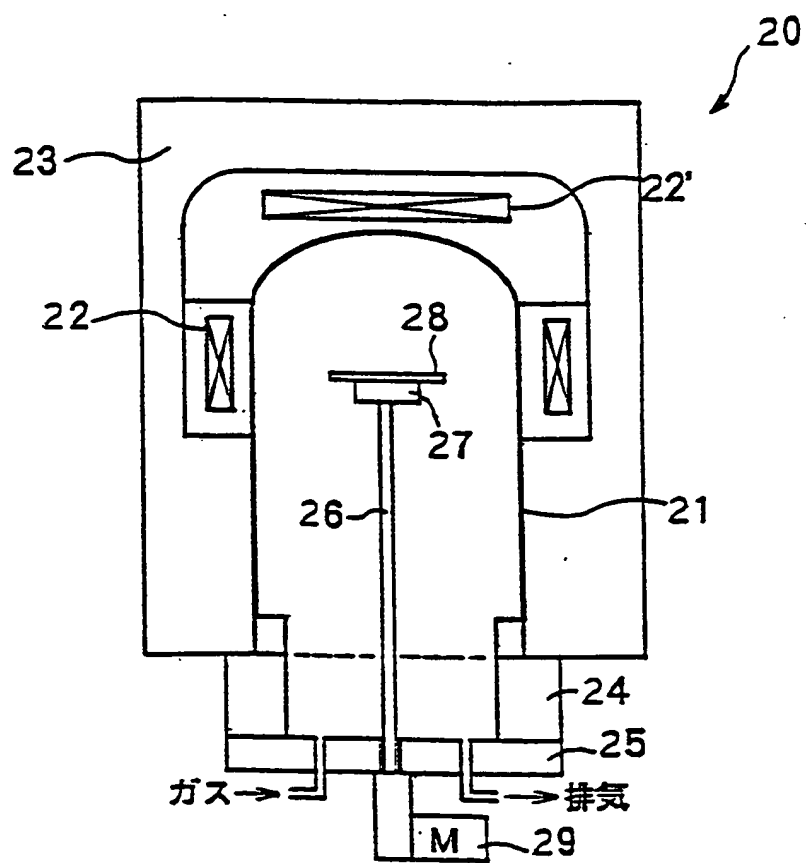


図 3



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05588

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl<sup>7</sup> H01L27/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>7</sup> H01L27/12, H01L21/265, H01L21/324

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No. |
|-----------|--|-----------------------|
| Y         | JP, 10-200080, A (Canon Inc.),<br>31 July, 1998 (31.07.98),<br>Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none)  | 1-8                   |
| Y         | JP, 9-260620, A (Shin Etsu Handotai Co., Ltd.),<br>03 October, 1997 (03.10.97),<br>Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)  | 1-8                   |
| Y         | JP, 4-115511, A (Fujitsu Limited),<br>16 April, 1992 (16.04.92),<br>Full text; Fig. 1 (Family: none)   | 1-8                   |
| Y         | JP, 10-275905, A (Mitsubishi Electric Corporation),<br>13 October, 1998 (13.10.98),<br>Full text; Fig. 1<br>& DE, 19753494, A & FR, 2761526, A<br>& FR, 2762136, A | 1-8                   |
| Y         | JP, 3-109731, A (Seiko Instr. Inc.),<br>09 May, 1991 (09.05.91),<br>Full text; Fig. 1 (Family: none)   | 1-8                   |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

|   |  |
|---|--|
| * Special categories of cited documents:  | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  |
| "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  | "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone   |
| "E" earlier document but published on or after the international filing date  | "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art |
| "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) | "&" document member of the same patent family  |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  |  |
| "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  |  |

Date of the actual completion of the international search  
14 December, 1999 (14.12.99)

Date of mailing of the international search report  
28 December, 1999 (28.12.99)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05588

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                        | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| A         | JP, 7-183477, A (NEC Corporation),<br>21 July, 1995 (21.07.95),<br>Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none) | 1-8                   |



## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L27/12

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> H01L27/12, H01L21/265, H01L21/324

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

|             |            |
|-------------|------------|
| 日本国実用新案公報   | 1922-1996年 |
| 日本国公開実用新案公報 | 1971-1999年 |
| 日本国登録実用新案公報 | 1994-1999年 |
| 日本国実用新案登録公報 | 1996-1999年 |

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
|-----------------|--|------------------|
| Y               | JP, 10-200080, A (キャノン株式会社)<br>31, 7月, 1998 (31, 07, 98)<br>全文、第1-3図 (ファミリーなし) | 1-8              |
| Y               | JP, 9-260620, A (信越半導体株式会社)<br>3, 10月, 1997 (03, 10, 97)<br>全文、第1-5図 (ファミリーなし) | 1-8              |
| Y               | JP, 4-115511, A (富士通株式会社)<br>16, 4月, 1992 (16, 04, 92)<br>全文、第1図 (ファミリーなし)     | 1-8              |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

14.12.99

国際調査報告の発送日

28.12.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

特許庁審査官 (権限のある職員)

齋藤 恭一



4 L

9835

| C (続き) . 関連すると認められる文献 |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー*       | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   | 関連する<br>請求の範囲の番号 |
| Y                     | J P, 10-275905, A (三菱電機株式会社)<br>13, 10月, 1998 (13, 10, 98)<br>全文、第1図<br>& DE, 19753494, A<br>& FR, 2761526, A<br>& FR, 2762136, A | 1-8              |
| Y                     | J P, 3-109731, A (セイコー電子工業株式会社)<br>9, 5月, 1991 (09, 05, 91)<br>全文、第1図 (ファミリーなし)   | 1-8              |
| A                     | J P, 7-183477, A (日本電気株式会社)<br>21, 7月, 1995 (21, 07, 95)<br>全文、第1-3図 (ファミリーなし)  | 1-8              |